

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 豊洲フォレシア
 ルネサス エレクトロニクス株式会社
 問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/contact/>
 E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-RX*-A184A/J	Rev.	第1版
題名	RX610グループ フラッシュメモリのP/Eサスペンドコマンドに関する誤記訂正		情報分類	技術情報	
適用製品	RX610 グループ	対象ロット等	関連資料	RX610 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.20 (R01UH0032JJ0120)	
		全ロット			

RX610 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編のROM (コード格納用フラッシュメモリ)章において、SUSRDY ビットの説明、およびP/E サスペンドコマンドのフローチャートに誤記がありましたので訂正いたします。

• Page 777 of 940

「26.2.5 フラッシュステータスレジスタ 0 (FSTATR0)」において、SUSRDY ビットの「“0”になる条件」に条件が不足していましたので、以下のとおり訂正いたします。

【変更前】

["0" になる条件]

- P/E サスペンドコマンドを受け付けた
- 書き込み/消去処理中に、コマンドロック状態に遷移した

【変更後】

["0" になる条件]

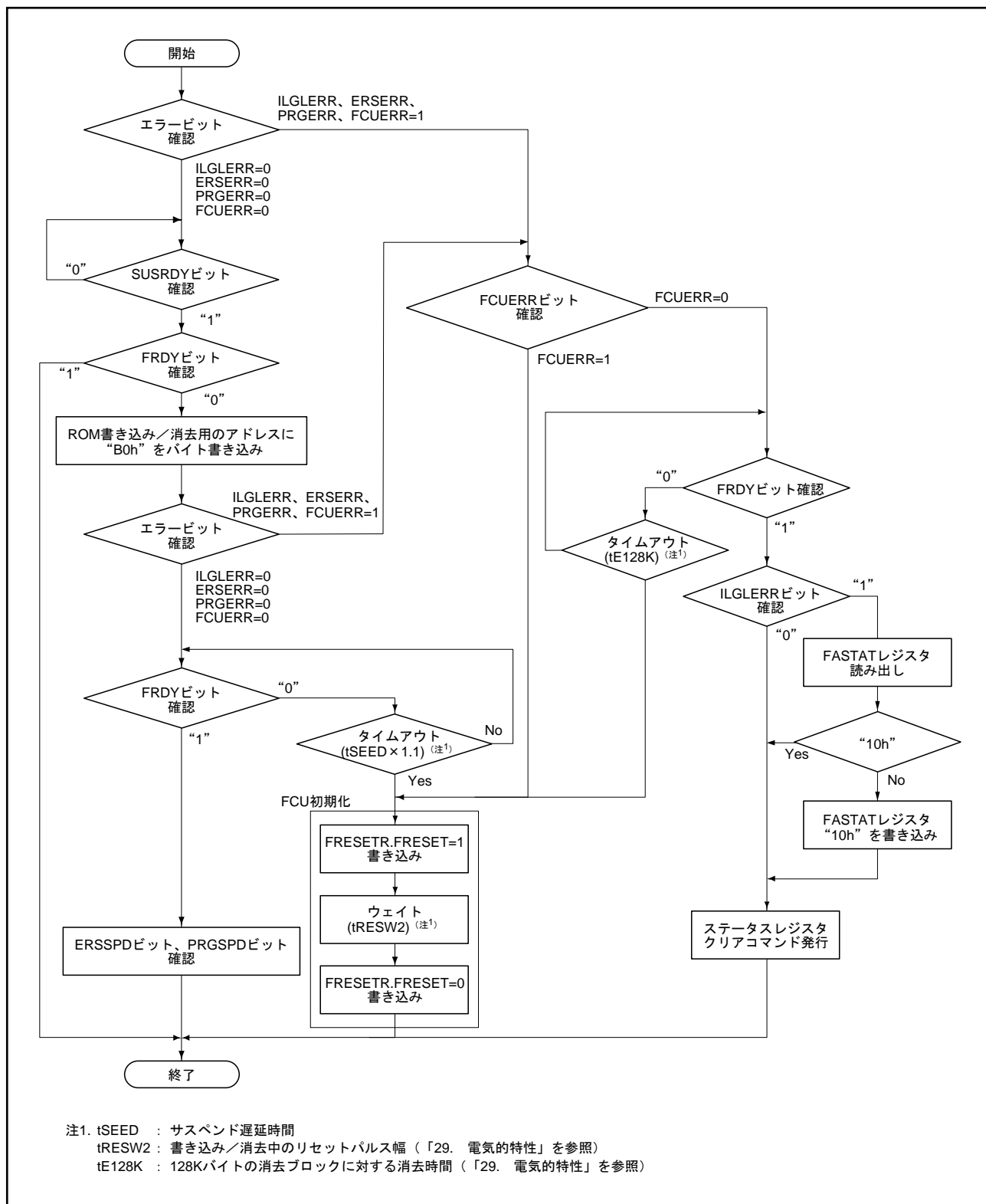
- P/E サスペンドコマンドを受け付けた
- 書き込み/消去処理中に、コマンドロック状態に遷移した
- **書き込み/消去処理が終了した**

• Page 815 of 940

「図 26.19 書き込み/消去のサスペンド方法」に示すフローでは、SUSRDY ビットを確認する前に書き込み/消去処理が終了していた場合に、この確認ループを抜けることができなくなります。

そのため、以下のとおりタイムアウト処理と、FRDY ビットが“1”であった場合の中断処理を追加いたします。

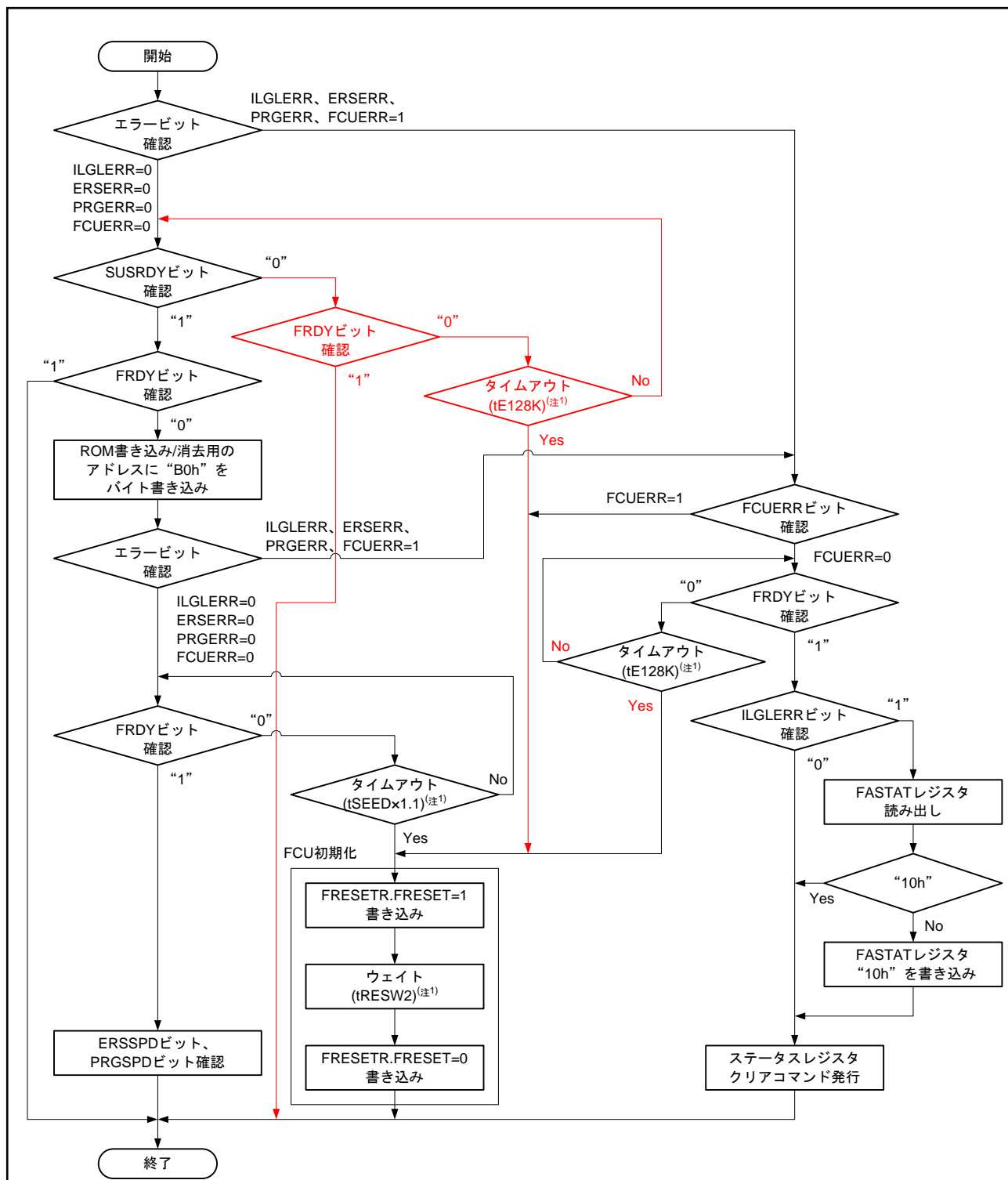
【変更前】



注1. tSEED : サuspend遅延時間
 tRESW2 : 書き込み/消去中のリセットパルス幅 (「29. 電気的特性」を参照)
 tE128K : 128Kバイトの消去ブロックに対する消去時間 (「29. 電気的特性」を参照)

図 26.19 書き込み/消去のサuspend方法

【変更後】



注1. tSEED : サスペンド遅延時間
 tFCUR : 書き込み/消去中のリセットパルス幅 (「29. 電気的特性」を参照)
 tE128K : 128Kバイトの消去ブロックに対する消去時間 (「29. 電気的特性」を参照)

図 26.19 書き込み/消去のサスペンド方法

以上